



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le **02 DEC. 2003**

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Planche', is written over a horizontal line.

Martine PLANCHE

**INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE**

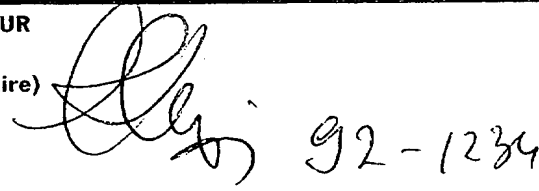

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr

THIS PAGE BLANK (USPTO)

<p>REMISE DES PIÈCES</p> <p>DATE 26 MARS 2003</p> <p>LIEU 75 INPI PARIS</p> <p>N° D'ENREGISTREMENT 0303699</p> <p>NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI</p> <p>DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI 26 MARS 2003</p>		<p>1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE</p> <p>Cabinet REGIMBEAU 20, rue de Chazelles 75847 PARIS CEDEX 17 FRANCE</p>	
<p>Vos références pour ce dossier (facultatif) 239971 D20507 OC</p>			
<p>Confirmation d'un dépôt par télécopie</p> <p><input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie</p>			
<p>2 NATURE DE LA DEMANDE</p> <p>Demande de brevet <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Demande de certificat d'utilité <input type="checkbox"/></p> <p>Demande divisionnaire <input type="checkbox"/></p> <p><i>Demande de brevet initiale</i> N° _____ Date _____</p> <p><i>ou demande de certificat d'utilité initiale</i> N° _____ Date _____</p> <p>Transformation d'une demande de brevet européen <i>Demande de brevet initiale</i> <input type="checkbox"/> N° _____ Date _____</p>		<p>Cochez l'une des 4 cases suivantes</p>	
<p>3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)</p> <p>TRAITEMENT SUPERFICIEL D'UNE PLAQUETTE SEMICONDUCTRICE AVANT COLLAGE</p>			
<p>4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE</p>		<p>Pays ou organisation _____ N° _____</p> <p>Date _____</p> <p>Pays ou organisation _____ N° _____</p> <p>Date _____</p> <p>Pays ou organisation _____ N° _____</p> <p>Date _____</p> <p><input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»</p>	
<p>5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Personne morale <input type="checkbox"/> Personne physique</p>		<p>S.O.I.TEC SILICON ON INSULATOR TECHNOLOGIES</p>	
<p>Nom ou dénomination sociale</p>		<p>SOCIETE ANONYME</p>	
<p>Prénoms</p>		<p>384711909</p>	
<p>Forme juridique</p>		<p>Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques, 38190</p>	
<p>N° SIREN</p>		<p>BERNIN</p>	
<p>Code APE-NAF</p>		<p>FRANCE</p>	
<p>Domicile ou siège</p>	<p>Rue</p>	<p>FRANÇAISE</p>	
	<p>Code postal et ville</p>	<p>N° de téléphone (facultatif)</p>	
	<p>Pays</p>	<p>N° de télécopie (facultatif)</p>	
<p>Nationalité</p>		<p>FRANÇAISE</p>	
<p>N° de téléphone (facultatif)</p>		<p>N° de télécopie (facultatif)</p>	
<p>Adresse électronique (facultatif)</p>		<p><input type="checkbox"/> S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»</p>	

BREVET D'INVENTION
CERTIFICAT D'UTILITÉ
REQUÊTE EN DÉLIVRANCE
 page 2/2

BR2

REMISE DES PIÈCES DATE LIEU 26 MARS 2003 75 INPI PARIS N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI 0303699		Réservé à l'INPI	DB 540 W / 210502
6 MANDATAIRE (s'il y a lieu)		239971 OC	
Nom			
Prénom			
Cabinet ou Société		Cabinet REGIMBEAU	
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel			
Adresse	Rue	20, rue de Chazelles	
	Code postal et ville	75847 PARIS CEDEX 17	
	Pays		
N° de téléphone (facultatif)		01 44 29 35 00	
N° de télécopie (facultatif)		01 44 29 35 99	
Adresse électronique (facultatif)		info@regimbeau.fr	
7 INVENTEUR (S)		Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques	
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non.: Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)	
8 RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> Établissement immédiat <input type="checkbox"/> Établissement différé	
Paiement échelonné de la redevance (en deux versements)		Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence): AG <input type="text"/>	
10 SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES ET/OU D'ACIDES AMINÉS		<input type="checkbox"/> Cochez la case si la description contient une liste de séquences	
Le support électronique de données est joint		<input type="checkbox"/>	
La déclaration de conformité de la liste de séquences sur support papier avec le support électronique de données est jointe		<input type="checkbox"/>	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes			
11 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI	
			

La présente invention concerne le collage de deux plaquettes comprenant des matériaux semiconducteurs afin de réaliser des structures pour la micro électronique, l'optique ou l'opto électronique.

5 L'invention concerne plus précisément la préparation des surfaces de collage des deux plaquettes à coller.

Afin de s'assurer une bonne qualité de mise en contact avant collage des deux plaquettes, il est nécessaire de mettre en œuvre un nettoyage des surfaces à coller.

10 Les nettoyages classiques rencontrés dans l'état de la technique comprennent des étapes consistant à plonger des plaquettes à traiter dans des bains de solution de nettoyage successifs.

Pour le nettoyage de surfaces de plaquettes en 15 semiconducteur, il est ainsi connu d'utiliser un traitement RCA qui comprend :

- un premier bain d'une solution de SC1 (acronyme anglo-saxon de « Standard Clean 1 ») ; contenant de l'hydroxyde d'ammonium (NH_4OH), du peroxyde d'hydrogène (H_2O_2) et de l'eau dé-ionisée. 20
- un deuxième bain d'une solution de SC2 (acronyme anglo-saxon de « Standard Clean 2 ») ; contenant de l'acide chlorhydrique (HCl) et du peroxyde d'hydrogène (H_2O_2) et de l'eau dé-ionisée.

25 Le premier bain est destiné principalement à retirer les particules isolées en surface de la plaquette et les particules enterrées au voisinage de la surface, et à les empêcher de se redéposer.

La solution de SC2 est destinée principalement à retirer 30 des contaminations métalliques qui ont pu se déposer en surface de la plaquette, en formant notamment des chlorures.

Cependant, le traitement par RCA n'est quelquefois pas suffisant, il n'enlève notamment pas ou peu les contaminants de type organique.

Or ces contaminants organiques peuvent diminuer
5 l'efficacité de l'enlèvement de matière du RCA.

Ils peuvent aussi porter préjudice à un bon collage des plaquettes lorsqu'ils se situent au niveau de l'interface de celles-ci.

C'est notamment le cas lorsqu'une des deux plaquettes
10 à coller a subi une implantation d'espèces atomiques avant collage au voisinage de la surface à coller suivi d'un détachement au niveau de la zone implantée au cours du procédé connu dit "Smart-Cut". Ces hydrocarbures peuvent dans ce cas, en présence de particules, conduire à la
15 formation de cloques superficielles à la plaquette obtenue après détachement et/ou de zones non transférées entre la zone au niveau de laquelle les espèces ont été implantées et la surface de cette plaquette. Ces cloques augmentent et/ou s'accroissent lors d'un traitement thermique, tel un
20 traitement thermique entrepris au cours du collage pour solidifier celui-ci. Ces hydrocarbures, ou ces contaminants organiques de manière plus générale, peuvent créer de tels problèmes de collage que le détachement n'ait pas lieu.

Pour enlever la contamination organique, on plonge
25 usuellement des plaquettes à coller dans un bain de CARO, qui est une solution contenant de l' H_2SO_4 et de l' H_2O_2 , à une température supérieure à 100°C .

Toutefois, ce type de solution a un coût économique élevé et présente des problèmes liés à la sécurité et à
30 l'environnement et à sa mise en œuvre (dans le cas notamment de plaquettes douze pouces par exemple).

De plus, les nettoyages utilisant la solution CARO nécessitent des étapes intermédiaires entre le bain à

solution CARO et le traitement par RCA, comprenant au moins deux bains de rinçage de la plaquette afin de retirer de la surface de la plaquette toute trace de la solution CARO présente en surface, avant son entrée dans la solution SC1.

5 Afin de résoudre de tels problèmes liés à l'utilisation de cette solution, il a été trouvé de remplacer la solution CARO par une solution ozonée (O3).

De même que la solution CARO, cette nouvelle solution ozonée est apte à enlever les hydrocarbures présents en surface de la plaquette par oxydation, mais a un coût économique plus modeste et constitue une solution moins dangereuse pour l'environnement et la sécurité.

10 En outre, ce traitement comprenant un bain de solution ozonée ne nécessite pas la mise en œuvre d'étapes intermédiaires de rinçage entre le bain ozoné et le traitement par RCA.

Optionnellement, la solution ozonée peut être assistée d'ondes mégasoniques pour faciliter l'enlèvement des particules.

20 D'autre part, pour ce qui est du collage entre deux plaquettes, il peut au moins, dans un premier temps, être réalisé par adhésion moléculaire, liée à l'hydrophilie des surfaces à coller.

Cependant, l'hydrophilie après la mise en œuvre d'un procédé comprenant un traitement par une solution de CARO ou par une solution ozonée, suivi d'un traitement RCA, reste peu différente d'avant la mise en œuvre du procédé.

La présente invention tend à améliorer cette situation en proposant selon un premier aspect un procédé de
30 préparation d'une surface d'une plaquette comprenant au moins superficiellement une couche en matériau semiconducteur, la plaquette étant destinée à être mise en contact avec une deuxième plaquette pour réaliser une

adhésion entre elles au niveau de la surface à préparer, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :

- a) oxyder la surface de la plaquette avec des espèces chimiques ozonées ;
- 5 b) nettoyer la surface de la plaquette au moyen d'espèces chimiques aptes à enlever des particules isolées et/ou enterrées, ainsi que des contaminants métalliques ;
- 10 c) oxyder la surface de la plaquette avec une solution ozonée.

Des aspects préférés du procédé de préparation d'une surface sont :

- l'étape c) est mise en œuvre après la mise en œuvre de l'étape b) ;
- 15 - l'étape b) comprend deux opérations successives :
 - b1) nettoyer la surface de la plaquette au moyen d'une solution apte à enlever des particules qui y sont isolées et/ou enterrées ;
 - b2) nettoyer la surface de la plaquette au moyen d'une solution apte à enlever des contaminants métalliques ;
- 20 - la solution utilisée lors de l'étape b1) est de type SC1 ;
- 25 - la solution utilisée lors de l'étape b2) est de type SC2.

Selon un deuxième aspect, l'invention propose un procédé de collage de deux plaquettes comprenant un procédé de préparation des surfaces des deux plaquettes selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend après la mise en œuvre du procédé de préparation de deux surfaces respectives des deux plaquettes une étape de collage des deux plaquettes au niveau des deux surfaces.

Des aspects préférés du procédé de collage sont :

- le collage est au moins en partie réalisé par hydrophilie au niveau de l'interface des deux plaquettes.

- le collage des deux plaquettes est accompagné d'un traitement thermique apte à solidifier le collage.

Selon un troisième aspect, l'invention propose une application d'un procédé selon l'une des trois revendications précédentes à la réalisation d'une structure semi conducteur-sur-isolant.

D'autres aspects, buts et avantages de l'invention sont décrits dans la suite de ce document en illustration de la figure suivante :

La figure 1 représente les différentes étapes d'un procédé selon l'invention.

Un premier objectif de l'invention concerne un enlèvement de contamination d'hydrocarbures à la surface d'une plaquette à coller.

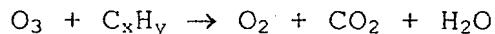
Un deuxième objectif de l'invention consiste à rendre hydrophile la surface de collage de la plaquette à coller juste avant collage.

Dans la technologie des semiconducteurs, des collages entre deux plaquettes sont quelquefois mis en œuvre afin de réaliser des structures telles que des structures de type SOI ou transistor ou toute autre structure.

La qualité du collage dépend notamment :

- de la faible rugosité des surfaces à coller ; et/ou
- d'une forte adhésivité entre les plaquettes ;
- du nombre de contaminants (organiques et métalliques) au voisinage des surfaces de collage.

Un traitement selon l'invention pour enlever de la contamination d'hydrocarbures consiste à mettre en contact une plaquette à coller avec une solution ozonée afin de réaliser la réaction chimique suivante :



On enlève ainsi les hydrocarbures en les oxydant par l'ozone.

Une solution ozonée peut permettre aussi d'enlever
5 certains contaminants métalliques tel que du cuivre ou de l'argent.

Un bain ozoné facilite aussi l'adhésivité des deux plaquettes à coller lorsque cette adhésivité est réalisée au moins en premier lieu par hydrophilie.

10 En effet, la présence d'ozone en surface de la plaquette permet d'augmenter l'hydrophilie, c'est-à-dire que lorsqu'on dépose une goutte d'eau sur la surface de la plaquette, elle prend la forme d'une calotte sphérique dont l'angle de raccordement entre la surface de la plaquette et
15 la tangente à la surface du liquide, appelé angle de contact, est moins important que dans un cas identique, sans ozone en surface de la plaquette.

Ainsi, pour une plaquette plongée dans un bain ozoné, l'angle de contact est typiquement compris entre 5 et 15
20 degrés, ce qui caractérise une surface à caractère hydrophile.

On dit qu'une telle surface à une bonne mouillabilité.

On voit ici le double intérêt de mettre en contact la plaquette à coller avec une solution ozonée.

25 En référence à la figure 1, est décrit un procédé de traitement de surface d'une plaquette à coller, mettant en œuvre une succession de traitements chimiques principalement destinés à diminuer la rugosité superficielle de la plaquette ainsi qu'à augmenter
30 l'hydrophilie de celle-ci.

Une première étape du procédé consiste à mettre en contact 10 la plaquette à un fluide (gaz ou liquide) ozoné
1.

Cette première étape est principalement destinée à enlever une majorité de contaminants organiques, tels que des hydrocarbures, en surface de la plaquette afin d'éviter tout défaut de collage, voire toute détérioration structurelle au niveau de l'interface de collage, et pouvant par là même provoquer une détérioration des structures finales à former.

On sait par exemple qu'un collage après implantation d'espèces atomiques réalisée lors, par exemple, de la mise en œuvre d'un procédé Smart-Cut, connu de l'homme du métier à une profondeur faible sous la surface, peut provoquer de telles détériorations, notamment au cours d'un traitement thermique.

Un autre intérêt de mettre en contact la plaquette avec un bain ozoné tient au fait que les contaminants organiques comprenant des résidus hydrocarbures retarde l'attaque du SCl du traitement RCA mis en œuvre lors de la seconde étape, et qu'en enlevant ces contaminants on restitue la vitesse de gravure du SCl , et donc l'efficacité de ce produit (un bon enlèvement de particules étant assuré par une gravure suffisante sous les particules qui sont ainsi « mises en suspension »).

En effet, la Demanderesse a mis en évidence, lors de mesures cartographiques effectuées sur une plaquette ayant subi un traitement SCl avec une étape préalable de trempage de la plaquette dans un bain ozoné, que les hydrocarbures protégeaient la partie de la plaquette qu'elles couvraient alors que les autres parties de la plaquette (non recouvertes par des contaminants hydrocarbures) étaient traitées sous l'action de la gravure chimique mise en œuvre par la solution SCl .

Le traitement SC1 ne gravait donc pas la surface de façon uniforme, et donnait alors une rugosité de la surface à coller sensiblement inégale.

En revanche, une plaquette ayant été traitée par une solution SC1 après trempage de la plaquette dans un bain
5 ozoné présentait une rugosité plus uniforme sur la surface.

Mettre en œuvre une étape de décontamination organique juste avant la mise en œuvre d'un traitement SC1 améliore donc l'efficacité du traitement SC1.

10 La Demanderesse a, en outre, comparé une attaque à la surface de la plaquette par une solution comprenant du CARO conforme à l'état de la technique, et la mise en contact de la plaquette avec une solution ozonée.

Des mesures d'épaisseur des couches superficielles
15 avant et après le nettoyage ont montré que l'efficacité d'oxydation des hydrocarbures était sensiblement identique pour les deux types de solution.

En revanche, le traitement de la plaquette avec une solution ozonée ne nécessite pas d'étape de rinçage
20 intermédiaire entre le traitement des contaminants organiques et le traitement RCA, comme c'était le cas pour le traitement au moyen d'une solution CARO.

Une seconde étape du procédé selon l'invention consiste à faire subir à la plaquette un traitement pour
25 enlever des particules isolées en surface et des contaminants métalliques.

Cette seconde étape comprend avantageusement un traitement de type RCA.

Une étape de traitement par RCA comprend deux opérations
30 principales :

- un traitement 20 par une solution de SC1 destiné à enlever les particules isolées en surface de la

plaquette et/ou enterrées au voisinage de la surface de celle-ci ; et

- un traitement 30 par une solution SC2 destiné à enlever des contaminations métalliques ayant pu se déposer en surface de la plaquette.

Le traitement par RCA est avantageusement mis en œuvre en association avec une application d'ondes mégasoniques, ces dernières aidèrent au décollement des particules.

Une troisième étape du procédé selon l'invention comprend la mise en contact 40 de la plaquette avec un second fluide ozoné 2 destiné principalement à augmenter l'hydrophilie en surface de la plaquette afin de pouvoir améliorer l'adhésivité de la plaquette lors de son collage avec une autre plaquette.

En effet, même si la plaquette a subi un premier traitement ozoné 1 au cours de la première étape, elle a perdu au moins en grande partie de l'hydrophilie au cours du traitement RCA.

Cette perte peut générer un mauvais collage, d'où l'intérêt principal de l'action de ce deuxième fluide ozoné 2 afin de rétablir une bonne hydrophilie en le situant dans le temps après les traitements de la seconde étape.

L'hydrophilie est augmentée notamment grâce aux propriétés d'activation de surface associées à la présence d'ozone en surface de la plaquette.

Cette bonne hydrophilie est associée à la formation de la couche d'oxyde par oxydation de la surface de la plaquette par l'ozone.

La mise en contact de la plaquette avec un fluide ozoné est mise en œuvre selon l'un des deux types de techniques suivantes :

- trempage de la plaquette dans un bain ozoné ; ou

- projection de gouttelettes d'ozone sur le dispositif de collage, simple ou accompagnée d'un rinçage avantageusement à l'eau dé-ionisée, afin de constituer une solution de rinçage ozonée ; ou
- 5 - envoi d'un gaz d'ozone.

Après les préparations des surfaces à coller de deux plaquettes, une ou plusieurs étapes de collage des deux plaquettes sont mises en œuvre.

Le collage consiste avantageusement à une adhésivité
10 hydrophile.

Dans une étape supplémentaire avantageuse, le collage est solidifié par un traitement adapté, tel qu'un traitement thermique.

Dans le cas où la couche d'oxyde formée lors de
15 l'oxydation d'une surface de collage d'au moins une des deux plaquettes ou lors d'une autre étape d'oxydation, cette couche d'oxyde peut améliorer l'adhésivité entre les deux plaquettes de par ses propriétés de collage.

Une étape supplémentaire au collage peut être mise en
20 œuvre afin de détacher un film d'une des deux plaquettes et le transférer sur l'autre plaquette, afin de réaliser sur l'ensemble comprenant la deuxième plaquette la structure souhaitée.

Dans le cas où l'une des deux surfaces à coller est
25 constituée d'une couche d'oxyde, cette couche d'oxyde peut dans certaines applications de la structure finale constituer une couche isolante électriquement.

C'est notamment le cas d'application à la formation de structures SeOI (acronyme anglo-saxon de "Semiconductor On
30 Insulator"), dont l'épaisseur semiconductrice est constituée du film transféré et la couche isolante est constituée de la couche d'oxyde formée lors de la mise en contact d'une des deux plaquettes avec un fluide ozoné.

Cependant, la présente invention ne se limite pas à une formation de structure de type SeOI, mais concerne la formation de tous types de structures comprenant un matériau semiconducteur.

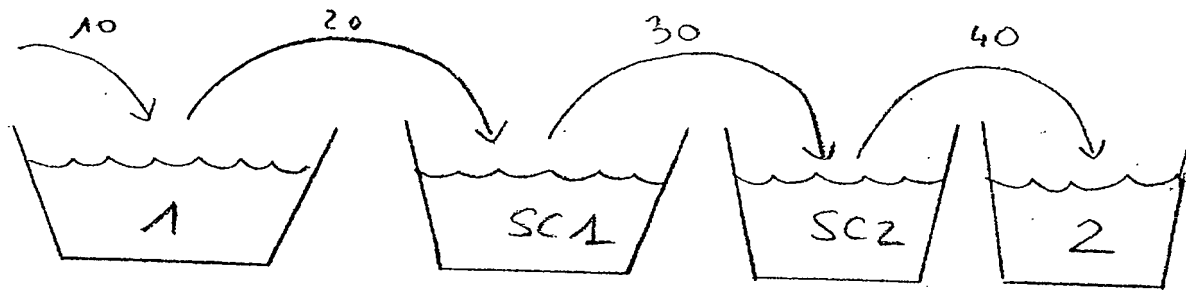
- 5 Les plaquettes traitées comprennent des matériaux semiconducteurs tels que le silicium, le germanium, le SiGe, l'AlGaAs, le GaAs, l'InGaAs, l'AlGaAsP, l'InGaAsP, l'InP, ou autres matériaux de type III-V ou II-VI.

REVENDICATIONS

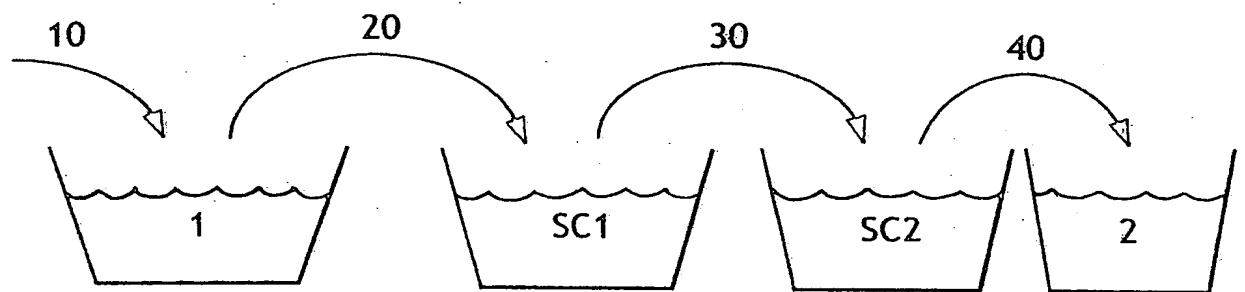
1. Procédé de préparation d'une surface d'une plaquette
comprenant au moins superficiellement une couche en
5 matériau semiconducteur, la plaquette étant destinée
à être mise en contact avec une deuxième plaquette
pour réaliser une adhésion entre elles au niveau de
la surface à préparer, caractérisé en ce qu'il
comprend les étapes suivantes :
 - 10 a) oxyder la surface de la plaquette avec des
espèces chimiques ozonées ;
 - b) nettoyer la surface de la plaquette au moyen
d'espèces chimiques aptes à enlever des
particules isolées et/ou enterrées, ainsi que
15 des contaminants métalliques ;
 - c) oxyder la surface de la plaquette avec une
solution ozonée.
2. Procédé de préparation d'une surface selon la
revendication précédente caractérisé en ce que
20 l'étape c) est mise en œuvre après la mise en œuvre
de l'étape b).
3. Procédé de préparation d'une surface selon l'une des
deux revendications précédentes, caractérisé en ce
que l'étape b) comprend deux opérations successives :
 - 25 b1) nettoyer la surface de la plaquette au moyen
d'une solution apte à enlever des particules
qui y sont isolées et/ou enterrées ;
 - b2) nettoyer la surface de la plaquette au moyen
d'une solution apte à enlever des contaminants
30 métalliques.
4. Procédé de préparation d'une surface selon la
revendication précédente caractérisé en ce que la

solution utilisée lors de l'étape b1) est de type SC1.

- 5 5. Procédé de préparation d'une surface selon l'une des deux revendications précédentes, caractérisé en ce que la solution utilisée lors de l'étape b2) est de type SC2.
- 10 6. Procédé de collage de deux plaquettes comprenant un procédé de préparation des surfaces des deux plaquettes selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend après la mise en œuvre du procédé de préparation de deux surfaces respectives des deux plaquettes une étape de collage des deux plaquettes au niveau des deux surfaces.
- 15 7. Procédé de collage de deux plaquettes selon la revendication précédente, caractérisé en ce que le collage est au moins en partie réalisé par hydrophilie au niveau de l'interface des deux plaquettes.
- 20 8. Procédé de collage de deux plaquettes selon l'une des deux revendications précédentes, caractérisé en ce que le collage des deux plaquettes est accompagné d'un traitement thermique apte à solidifier le collage.
- 25 9. Application d'un procédé selon l'une des trois revendications précédentes à la réalisation d'une structure semi conducteur-sur-isolant.



1 / 1



DÉPARTEMENT DES BREVETS

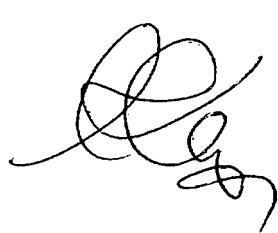
26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° . 1 . / 1 . .(À fournir dans le cas où les demandeurs et
les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

08 113 W / 270601

Vos références pour ce dossier (facultatif)		239971 D20507 OC	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		0303699	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)			
TRAITEMENT SUPERFICIEL D'UNE PLAQUETTE SEMICONDUCTRICE AVANT COLLAGE			
LE(S) DEMANDEUR(S) :			
S.O.I.TEC SILICON ON INSULATOR TECHNOLOGIES : Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques, 38190 BERNIN - FRANCE			
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :			
1 Nom		MALEVILLE Christophe	
Prénoms			
Adresse	Rue	90 Rue du Château	
	Code postal et ville	38660 LA TERRASSE FRANCE	
Société d'appartenance (facultatif)			
2 Nom		MAUNAND TUSSOT Corinne	
Prénoms			
Adresse	Rue	1, avenue du Vercors	
	Code postal et ville	38240 MEYLAN FRANCE	
Société d'appartenance (facultatif)			
3 Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.			
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)			
 92-1234			